



شبیه‌سازی کلید Q الکترو اپتیک در یک لیزر دایود پمپ $\text{Er}^{+3}:\text{Yb}^{+3}:\text{Glass}$

نسترن شمس الدینی، غلامرضا هنرآسا و امیر نوفرستی

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز

چکیده - در این مقاله به شبیه‌سازی کلید زنی Q به روش الکترواپتیک در یک لیزر $\text{Er}:\text{Yb}:\text{Glass}$ می‌پردازیم. به این منظور با استفاده از حل عددی معادلات نرخ وابسته به زمان تعداد فوتون‌های درون کاواک و جمعیت ترازها را محاسبه می‌کنیم. سپس با استفاده از تابع عبور مناسب برای بلور الکترواپتیک، توان خروجی لیزر را به دست می‌آوریم. نتایج نشان می‌دهد می‌توان به انرژی پالس ۱۰ میکرو ژول، توان قله ۵۷۶ وات و پهنای پالس ۱۷ نانوثانیه دست یافت.

کلید واژه-معادلات نرخ، کلید زنی Q بلور الکترو اپتیک، لیزر $\text{Er}:\text{Yb}:\text{Glass}$ ، پهنای پالس

Simulation of Electro-Optic Q-switch in a Diode Pumped $\text{Er}^{+3}:\text{Yb}^{+3}:\text{Glass}$ Laser

Nastaran Shamsodini, Gholamreza Honarasa, Amir Nofaresti

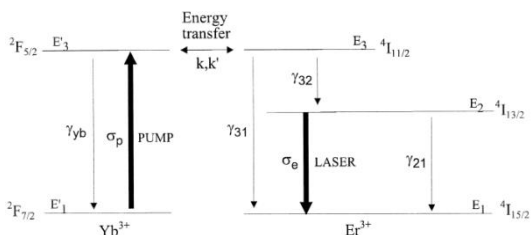
Department of Physics, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran

Abstract- In this paper, electro-optic Q-switching in an $\text{Er}:\text{Yb}:\text{Glass}$ laser is simulated. For this purpose, the photon number in the cavity and level populations are calculated using numerical solution of time dependent rate Equations. Then, the laser output power is obtained using proper transmission function of the electro-optic crystal. The results show that pulse Energy 10 μj , peak power 576 W and pulse duration 17ns can be achieved.

Keywords: Rate Equations, Electro Optic Q -Switched, $\text{Er}:\text{Yb}:\text{Glass}$ Laser, Pulse Duration

۱- مقدمه

از اوایل دهه ۱۹۸۰ با پیشرفت دایود لیزرهای توان بالا، تحقیق در زمینه‌ی لیزرهای دایود-پمپ حالت جامد مورد توجه قرار گرفت. آزمایشی این نوع لیزرهای پالسی، داشتن پیکربندی کوچک و همچنین خروجی با پهنای پالس نانو ثانیه می‌باشد [۱]. لیزر اربیم-ایتربیم آلاینده شده با شیشه از جمله لیزرهای حالت جامد سه ترازه در ناحیه چشم ایمن است و با طول موج ۱۵۴۰ نانومتر است [۲].



شکل ۱. ترازهای انرژی لیزر Er³⁺:Yb³⁺:Glass

کلید زنی Q به روش الکترواپتیک به دلیل سرعت بالا و کنترل خوب روی عمل کلیدزنی یکی از پرکاربردترین روش‌های کلیدزنی Q است. کلیدزنی Q با استفاده از دو ولتاژ $\lambda/2$ و $\lambda/4$ انجام می‌شود که در آنها به ترتیب بلور الکترواپتیک به تیغه $\lambda/2$ و تیغه $\lambda/4$ تبدیل می‌شود [۳]. در کار حاضر از ولتاژ $\lambda/2$ استفاده می‌شود. در این مقاله با استفاده از معادلات نرخ و تخمین عبور بلور الکترواپتیک مدلی برای شبیه سازی انرژی و پهنای پالس پرتو خروجی ارائه می‌دهیم.

۴- حل معادلات نرخ

در کلید زنی Q لیزر اربیم-ایتربیم آلاینده با شیشه به روش الکترو اپتیک، می‌توان با ایجاد اتلاف در کاواک، جمعیت معکوس را به میزان زیادی افزایش داد. وقتی جمعیت معکوس به میزان بالایی رسید ناگهان عامل اتلاف در کاواک حذف می‌شود و نوسانات لیزر آغاز می‌شود [۴]. با توجه به شکل ۱، با تابش پمپ، جمعیت از تراز $2F_{7/2}$ ایتربیم به تراز بالایی $2F_{5/2}$ یون ایتربیم منتقل می‌شود. سپس با توجه به همپوشانی خوب بین تراز بالایی ایتربیم و تراز $4I_{13/2}$ اربیم، جمعیت پمپ شده از تراز $2F_{5/2}$ ایتربیم به تراز $4I_{13/2}$ اربیم انتقال می‌یابد. بین تراز $4I_{13/2}$ و $4I_{15/2}$ ، پرتو خروجی لیزر تشکیل می‌شود. با در نظر گرفتن فرضیات زیر معادلات جفت شده را برای جمعیت ترازهای مختلف به دست می‌آوریم. اولین فرض به دلیل نیمه عمر کوتاه تراز $4I_{11/2}$ اربیم، جمعیت پمپ شده به تراز $2F_{5/2}$ طی یک فرو افت سریع به تراز $4I_{13/2}$ انتقال می‌یابد. بنابراین جمعیت تراز $4I_{11/2}$ تقریباً ثابت است ($\frac{dN_3}{dt} = 0$). در فرض دوم از برگشت انتقال انرژی K' از تراز $4I_{11/2}$

معادله نرخ برای E_2 و E_3 به صورت زیر نوشته می‌شود [۴] و [۵]:

$$\frac{dN'_3}{dt} = \sigma_p N_{yb} \varphi_p - kN'_3 (N_{er} - N_2) - \gamma_{yb} N'_3 \quad (1)$$

$$\frac{dN_2}{dt} = kN'_3 (N_{er} - N_2) - \gamma_{21} N_2 - (2N_2 - N_{er}) \sigma_e \varphi_l N_L \frac{c_0}{n} \quad (2)$$

که در آن $N_{yb} = N'_1 + N'_3$ چگالی اتمی یون ایتربیم، $N_{er} = N_1 + N_2 + N_3$ چگالی اتمی یون اربیم و N_L تعداد فوتون های درون کاواک است. همچنین k آهنگ انتقال انرژی از تراز $2F_{5/2}$ ایتربیم به تراز $4I_{13/2}$ اربیم و σ_p و σ_e به ترتیب سطح مقطع جذب و گسیل هستند. γ_{21} آهنگ فروافت از تراز ۲ به تراز ۱ اربیم، γ_{yb} آهنگ فروافت تراز بالایی ایتربیم و c_0 سرعت نور در خلا است. φ_p شار فوتون دمش شده با توزیع یکنواخت که به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\varphi_p = \frac{p_p (1 - e^{-\alpha l})}{h\nu_p S \alpha l} \quad (3)$$

که در آن p_p توان پمپ، α ضریب جذب اربیم- شیشه، l طول ماده فعال و S مساحت پرتو لیزر $S = \pi w_l^2$ است [۴]. حال تعداد فوتون ها را در حجم کاواک V که به وسیله گسیل القایی ایجاد می‌شود به صورت زیر تعریف می‌کنیم [۴]:

$$\iint_V \sigma_e (N_2 - N_1) \frac{c_0}{n} N_L(t) \varphi_l(r) dV \quad (4)$$

به منظور شبیه سازی کلیدزنی به روش الکترواپتیک تابع عبور برای سلول الکترو اپتیک را به صورت زیر تعریف می کنیم [۲]:

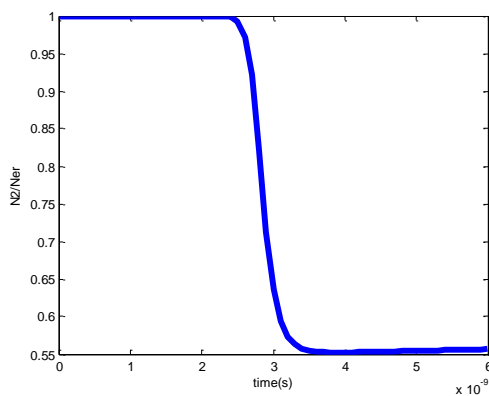
$$T = T_0 \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} \frac{V}{V_{\lambda/4}} \right) \quad (9)$$

که V ولتاژ وابسته به زمان برای کلید زنی Q الکترو اپتیک اثر پاکلز با تیغه $\frac{\lambda}{4}$ و T_0 ماکزیمم عبور سلول الکترواپتیک است. وابستگی ولتاژ به زمان را به شکل یک تابع شبه سرتخت به صورت زیر در نظر می گیریم:

$$V = V_{\lambda/4} \exp \left[-2 \left(\frac{t-t_0}{w_t} \right)^{2N} \right] \quad (10)$$

که در آن N یک عدد صحیح و w_t پهنای تابع است و به ترتیب مقادیر ۳ و ۱۶ میکرو ثانیه را برای آنها انتخاب می کنیم.

شکل های ۲ و ۳ نسبت جمعیت N_2/N_{er} و N_3/N_{yb} را بر حسب زمان نشان می دهند. با توجه به شکل ها، مشاهده می شود که N_2 کاهش یافته اما N_3 با افت کمی توام است و تقریباً ثابت باقی می ماند. زمان نشان داده شده در شکل ها مربوط به زمان بعد از پمپ (بعد از ۸ میلی ثانیه) است.



شکل ۲: نسبت جمعیت ترانز E_2 به چگالی اتمی یون اربوم N_2/N_{er} بر حسب زمان.

که در آن $\varphi_l(r)$ شار فوتون لیزر با توزیع یکنواخت از رابطه ی زیر به دست می آید:

$$\varphi_l(r) = \frac{n}{L_{opt} S} \quad (5)$$

به طوری که $L_{opt} = nl$ است. بنابراین برای تغییرات تعداد فوتون های درون کاواک خواهیم داشت:

$$\frac{dN_L}{dt} = N_L \left[-\frac{1}{\tau_{cavity}} + \frac{c_0 \sigma_e (2N_2 - N_{er})}{n} \right] \quad (6)$$

که در آن τ_{cavity} اتلاف درون کاواک است و از رابطه زیر به دست می آید:

$$\tau_{cavity} = -\frac{2L_{opt}}{\ln[R_1 R_2] c_0} \quad (7)$$

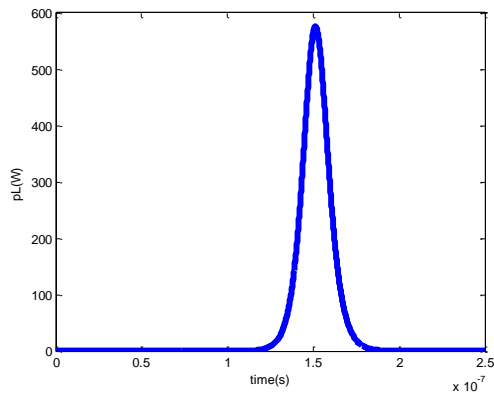
که R_1 و R_2 بازتاب آینه هاست. از سه معادله جفت شده (۱)، (۲) و (۶) می توان توان لیزر و نحوه تغییر جمعیت ترانزها را بر حسب زمان به دست آورد. برای شبیه سازی لیزر ابتدا محیط فعال را با توان یک وات و به مدت ۸ میلی ثانیه پمپ می کنیم. با استفاده از معادلات نرخ در انتهای ۸ میلی ثانیه $N_2/N_{er} \approx 1$ و $N_3/N_{yb} \approx 0.47$ به دست می آید.

۳- شبیه سازی کلیدزنی Q

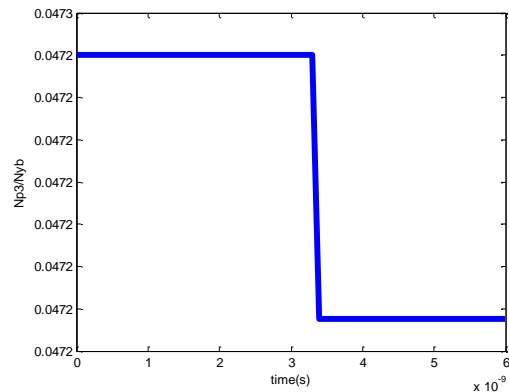
در کلید زنی Q به روش الکترو اپتیک از یک سلول پاکلز با تیغه $\frac{\lambda}{4}$ استفاده می شود. وقتی نور قطبیده تخت به بلور الکترو اپتیک وارد می شود، می توانیم با اعمال ولتاژ مناسب از مرتبه کیلوولت، برای تولید میدان در امتداد پرتو عبوری، صفحه قطبش را ۹۰ درجه بچرخانیم. در نتیجه نور بازتابیده از آینه طی یک رفت و برگشت از بلور بار دیگر قادر به عبور از قطبنده نخواهد بود. این کار باعث ایجاد اتلاف درون کاواک، برای افزایش جمعیت معکوس خواهد بود [۱۶]. در این حالت τ_{cavity} را به صورت زیر تعریف می کنیم:

$$\tau_{cavity} = -\frac{2L_{opt}}{\ln[R_1 R_2 T^2] c_0} \quad (8)$$

که در آن T میزان عبور از بلور الکترواپتیک را نشان می دهد.



شکل ۵: توان خروجی لیزر برحسب زمان.

شکل ۳: نسبت جمعیت تراز E'_3 به چگالی اتمی یون ایتربیم N_3 / N_{yb} برحسب زمان.

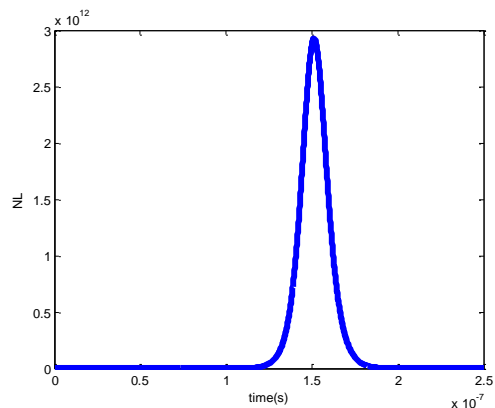
۴- نتیجه‌گیری

در این مقاله با حل معادلات نرخ و با استفاده از یک تابع عبور مناسب برای بلور الکترواپتیک، کلیدزنی Q را در لیزر Er:Yb:Glass شبیه سازی کردیم. نتایج نشان می‌دهد با انتخاب پهنای مناسب (حدود ۱۶ میکروثانیه) برای ولتاژ اعمالی به بلور الکترواپتیک می‌توان به پهنای پالسی در حدود ۱۷ نانو ثانیه با انرژی پالس تقریباً ۱۰ میکرو ژول و توان قله ۵۷۶ دست یافت.

مراجع

- [1] E. Tanguy, C. Larat, J. P. Pocholle, "Modelling of the erbium-ytterbium laser", Opt. Commun., Vol. 153, pp. 172-183, 1998.
- [2] W. Koechner, M. Bass, *Solid-State Lasers: A Graduate Text*, Springer Verlag, New York, 2003.
- [3] J. Guang-Yong, W. Chun-Ting, C. Xin-Yu, Y. Yong-Ji and W. Chao, "An Innovative Electro-Optic Q-Switch Technology in 1064nm and 1319nm Dual-Wavelength Operation of a Nd:YAG Laser", Chin. Phys. Lett., Vol. 30, No. 3, pp. 034209, 2013.
- [4] X. Zhang, S. Zhao, Q. Wang, B. Ozygus, H. Weber, "Modeling of diode-pumped actively Q-switched lasers", IEEE J. Quant. Electron., Vol. 35, No. 12, pp. 1912-1918, 1999.
- [5] D. Shen, J. Sahu and W. Clarkson, "Electro-optically Q-switched Er:YAG Laser In-band Pumped by an Er,Yb Fiber Laser", Advanced Solid-State Photonics, WD4, 2006.
- [6] W. Zendzian, J. K. Jabczynski, J. Kwiatkowski and K. Kopczynski, "300-kW, Eye-Safe Intracavity OPO Transmitter", Proc. of SPIE, Vol. 6952, pp. 69520U, 2008.

شکل ۴ توزیع فوتون‌های درون کاواک را نشان می‌دهد که نشان دهنده یک قله شدید با پهنای نانو ثانیه است.



شکل ۴: منحنی فوتون‌های درون کاواک وقتی کلید Q فعال است.

توان خروجی لیزر وقتی کلید Q فعال است از رابطه زیر محاسبه می‌شود [۴]:

$$P_L(t) = h\nu_l N_L(t) / \tau_{cavity} \quad (10)$$

که در آن $h\nu_l$ انرژی فوتون‌های لیزر است. نمودار توان خروجی لیزر برحسب زمان در شکل ۵ رسم شده است. مقدار توان قله با توجه به شکل ۵، ۵۷۶ وات است. همچنین با محاسبه‌ی پهنای در نصف مقدار ماکزیمم توان، پهنای پالس ۱۷ نانو ثانیه به دست می‌آید. بنابراین انرژی هر پالس تقریباً برابر با ۱۰ میلی ژول به دست می‌آید.